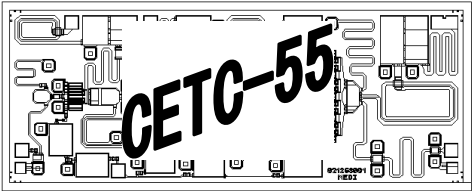


特性

- NPN 型硅微波脉冲功率管
- 共基极结构
- 宽带 C 类工作状态
- 扩散发射极镇流电阻
- 纯金金属化系统
- 输入输出阻抗抗内匹配电路设计
- 气密性陶瓷封装



最大额定值（环境温度 25℃）

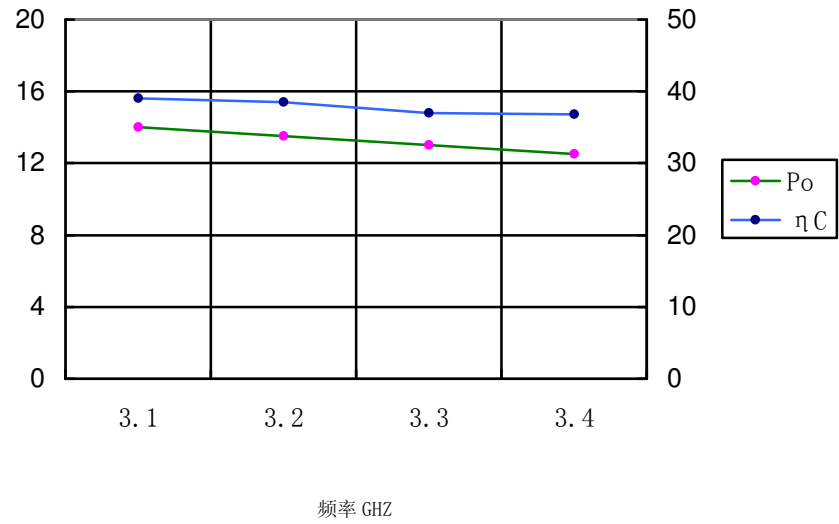
参 数	符号	数 值	单位
集电极基极击穿电压	BV_{CBO}	60	V
发射极基极击穿电压	BV_{EBO}	3	V
集电极电流	I_{CP}	2	A
最大耗散功率	P_{tot}	8.0	W
结温	T_J	200	℃
储存温度	T_{STG}	-65 to +200	℃

电性能（环境温度 25℃）

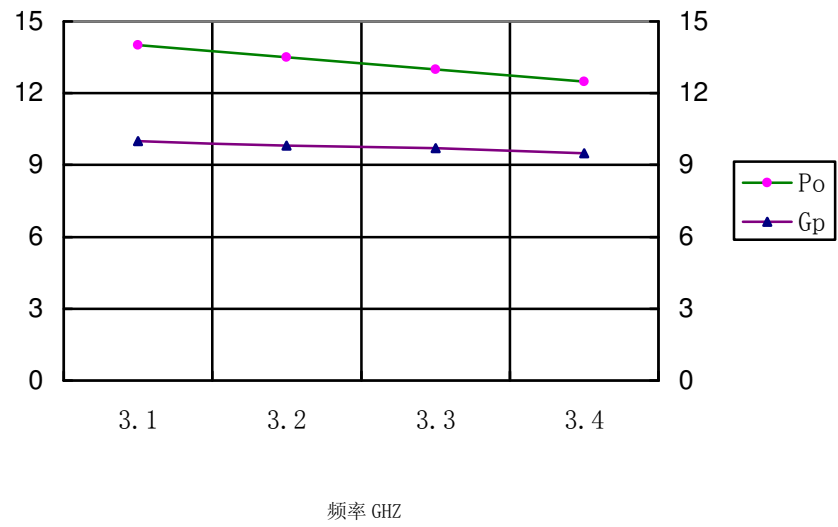
参数名称	符号	单位	参数值			测 试 条 件
			Min	Typ	Max	
集电极基极击穿电压	BV_{CBO}	V	60			$I_E=0 \quad I_C \leq 10mA$
集电极基极截止电流	I_{CBO}	mA		1.0		$I_E=0 \quad V_{CB}=40V$
热阻	$R_{TH(JC)}$	℃/W		21.9		$V_{CE}=10V, I_C=0.5A, t_w=1s$
工作频率	f	MHz	3100~3400			若不另加说明带内 3 点测试
工作电压	U	V	32			
输出功率	P_o	W	11		14.5	
输入功率	P_{IN}	W		1.4		
功率增益起伏	ΔGP	dB		1.0		
效率	η_c	%	36			
脉冲宽度	T	μs		300		
工作比	D	%		10		
顶将	Droop	dB			0.5	
抗失配驻波比	VSWR			3:1		
杂波抑制比		dBc	-65			

典型测试曲线

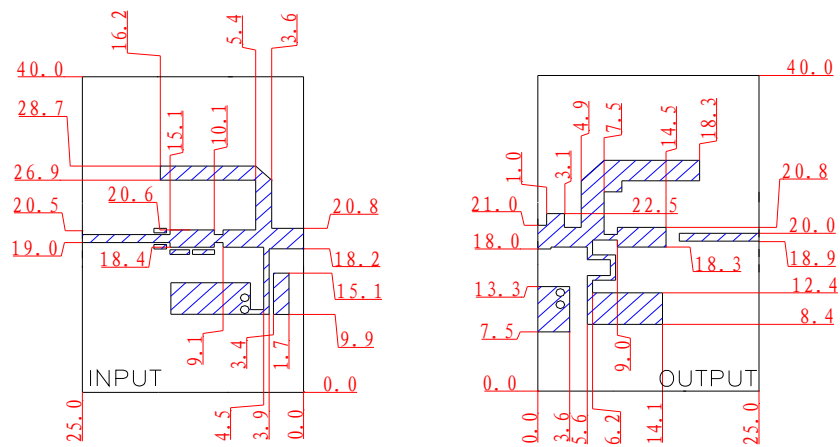
功率效率曲线



功率增益曲线



输入输出电路版图:



介质板型号: TMM10-0.04-0.5E/0.5E, ROGRES公司

管壳尺寸图

